

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成 17 年 10 月 13 日 (2005.10.13)

【公開番号】特開 2000-91624 (P2000-91624A)  
【公開日】平成 12 年 3 月 31 日 (2000.3.31)  
【出願番号】特願 平 10-256991  
【国際特許分類第 7 版】  
H 0 1 L 31/16  
【F I】  
H 0 1 L 31/16 B

【手続補正書】  
【提出日】平成 17 年 6 月 1 日 (2005.6.1)  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】特許請求の範囲  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】  
【請求項 1】

受光面上の基線長方向の入射光位置に応じて半導体導電層の両端部からそれぞれ出力される電流値が可変する半導体位置検出器において、

該電流がそれぞれ取り出される一対の信号取出電極と、

前記両端部の少なくとも一方と前記信号取出電極との間の電流経路内に介在する外側半導体領域とを備え、

前記外側半導体領域は前記半導体導電層よりも前記基線長方向単位長当たりの抵抗値が小さく且つ入射光を受光可能なように前記両端部の少なくとも一方に連続して設けられていることを特徴とする半導体位置検出器。

【請求項 2】

受光面上のチップの長手方向の入射光位置に応じて半導体導電層の両端部からそれぞれ出力される電流値が可変する半導体位置検出器において、

該電流がそれぞれ取り出される一対の信号取出電極と、

前記両端部の少なくとも一方と前記信号取出電極との間の電流経路内に介在する外側半導体領域とを備え、

前記外側半導体領域は前記半導体導電層よりも前記チップの長手方向単位長当たりの抵抗値が小さく且つ入射光を受光可能なように前記両端部の少なくとも一方に連続して設けられていることを特徴とする半導体位置検出器。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】0 0 0 7  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【0 0 0 7】  
【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明に係る半導体位置検出器は、受光面上の基線長方向の入射光位置に応じて半導体導電層の両端部からそれぞれ出力される電流値が可変する半導体位置検出器において、この電流がそれぞれ取り出される一対の信号取出電極と、上記両端部の少なくとも一方と信号取出電極との間の電流経路内に介在する外側半導体領域とを備え、外側半導体領域は半導体導電層よりも基線長方向単位長当たりの抵抗値が小さく且

つ入射光を受光可能なように上記両端部の少なくとも一方に連続して設けられていることを特徴とする。

また、本発明に係る半導体位置検出器は、受光面上のチップの長手方向の入射光位置に応じて半導体導電層の両端部からそれぞれ出力される電流値が可変する半導体位置検出器において、この電流がそれぞれ取り出される一对の信号取出電極と、両端部の少なくとも一方と信号取出電極との間の電流経路内に介在する外側半導体領域とを備え、外側半導体領域は半導体導電層よりもチップの長手方向単位長当たりの抵抗値が小さく且つ入射光を受光可能なように両端部の少なくとも一方に連続して設けられていることを特徴とする。